物理学报 Acta Physica Sinica

Chinese Physical Society

Institute of Physics, CAS

Ga₂ 基 Heusler 合金 Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu)的四方畸变、电子结构、磁性及声子谱的第一性原 理计算

陈家华 刘恩克 李勇 祁欣 刘国栋 罗鸿志 王文洪 吴光恒

First-principles investigations on tetragonal distortion, electronic structure, magnetism, and phonon dispersion of Ga_2XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu) Heusler alloys

Chen Jia-Hua Liu En-Ke Li Yong Qi Xin Liu Guo-Dong Luo Hong-Zhi Wang Wen-Hong Wu Guang-Heng

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 64, 077104 (2015) DOI: 10.7498/aps.64.077104 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.077104 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I7

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

N, Fe, La 三掺杂锐钛矿型 TiO₂ 能带调节的理论与实验研究

Theoretical and experimental studies on N, Fe, La co-doped anatase TiO₂ band adjustment 物理学报.2015, 64(1): 017101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.017101

立方相 Na_{1/2}Bi_{1/2}TiO₃和 K_{1/2}Bi_{1/2}TiO₃的电子结构和结构不稳定性的第一性原理比较研究 Electronic structures and phase instabilities of cubic Na_{1/2}Bi_{1/2}TiO₃ and K_{1/2}Bi_{1/2}TiO₃: a first-principles comparative study 物理学报.2014, 63(16): 167101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.167101

 $CuHg_2Ti$ 型 Ti_2Cr 基合金的电子结构、能隙起源和磁性研究

Electronic structures, band-gap origins and magnetisms of Ti₂Cr-based alloys with CuHg₂Ti-type structure 物理学报.2014, 63(10): 107103 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.107103

P掺杂硅纳米管电子结构与光学性质的研究

The electronic structure and optical properties of P-doped silicon nanotubes 物理学报.2014, 63(6): 067102 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.067102

正交多铁性材料 DyMnO3 的磁性质研究

Magnetic properties of multiferroic material DyMnO₃ in orthorhombic structure 物理学报.2013, 62(22): 227101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.227101

Ga₂ 基Heusler 合金Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu)的四方畸变、电子结构、磁性及 声子谱的第一性原理计算^{*}

陈家华¹⁾²⁾ 刘恩克^{2)†} 李勇²⁾³⁾ 祁欣^{1)‡} 刘国栋³⁾ 罗鸿志³⁾ 王文洪²⁾ 吴光恒²⁾

1)(北京化工大学理学院,北京 100029)
 2)(中国科学院物理研究所磁学国家重点实验室,北京 100190)
 3)(河北工业大学材料学院,天津 300130)
 (2014年5月3日收到;2014年11月3日收到修改稿)

运用基于密度泛函理论的第一性原理的方法,对Ga2基Heusler合金Ga2XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu)的四方畸变、电子结构、磁性及声子谱特性进行了系统的研究.结果表明,在保持体积不变的四方畸变中,五种合金的磁矩主要由Cr元素提供;Ga2FeCr,Ga2CoCr和Ga2CuCr保持稳定的立方相,而在Ga2MnCr和Ga2NiCr中观察到能量更低的四方相,且其能量最低点对应的c/a分别位于1.28和1.11处,而对应的能量差 ΔE 分别为-8.26 meV和-6.14 meV.电子结构显示,Ga2MnCr和Ga2NiCr的费米能级附近存在尖锐的电子态密度峰,导致3d电子能级杂化向宽能量范围扩展,以消除体系的高能量不稳态,这个过程导致结构转变的发生.基于适度的畸变度和能量差,本文认为Ga2MnCr有存在铁磁马氏体相变的可能,其声学支虚频的出现,也进一步表明体系有声子模软化的行为.

关键词: Heusler 合金, 铁磁马氏体相变, 第一性原理计算 PACS: 71.20.-b, 81.30.Kf, 75.50.Cc

DOI: 10.7498/aps.64.077104

目前已报道的Heusler型FSMAs主要是 Ni₂, Mn₂, Co₂和Fe₂基体系如Ni₂MnGa^[11],

Ni-Mn-X $(X = \text{In}, \text{Sn} \# \text{Sb})^{[12]}, \text{Ni}_2\text{FeGa}^{[13]}, \text{Mn}_2\text{NiGa}^{[14]}, \text{Co-Ni-Ga}(\text{Al})^{[15,16]}, \text{Co}_2\text{Cr}$ (Ga,

Si)^[17]和Fe₂MnGa^[18,19],其正分化学式是X₂YZ

或Y₂XZ(X, Y 是过渡族元素, Z 是主族元素). 在

这些FSMAs体系中,主族元素Z的组成成分通

常不大于25%. 事实上, Heusler 合金还存在另

外一种 Z_2 基(Z_2XY)的类别,如Ga₂MnCo^[20]和

Al₂MnCo^[21]. 最近 Barman 等的计算和实验研究

表明, Ga₂MnNi 具有马氏体相变而成为一种新的 Z_2 基Heusler型FSMA^[22], 马氏体相变温度和居

1引言

近年来,铁磁形状记忆合金(ferromagnetic shape memory alloys, FSMAs)在磁场的作用下表现出丰富的物理性质如磁场诱发应变^[1]、磁场驱动形状记忆效应^[2]、磁熵变^[3]、磁电阻^[4]、霍尔效应^[5]和交换偏置^[6]等而备受关注.这些优异的物理性质使FSMAs在许多技术领域中如磁驱动器^[7,8]、传感器^[9]、磁制冷^[10]等具有潜在的应用价值.因此,寻找和开发新的铁磁形状记忆合金成为当前重要的研究内容.

^{*} 国家自然科学基金(批准号: 51301195, 51275029)资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: ekliu@iphy.ac.cn

[‡]通信作者. E-mail: qixin@mail.buct.edu.cn

^{© 2015} 中国物理学会 Chinese Physical Society

里温度分别是 780 K和 330 K, 四方结构马氏体 相的 c/a = 0.84. 这些实验结果为寻找新的 Z_2 基 FSMAs 提供了重要的启示.

本文运用基于密度泛函理论的第一性原理方 法, 计算了 Z_2 基 Heusler 合金 Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu) 的四方畸变、电子结构、磁性及声子 谱. 计算结果表明, Ga₂XCr (X = Fe, Co, Cu) 的 立方相 (c/a = 1) 是稳定态且不随 c/a 的变化而变 化, 因此 Ga₂XCr (X = Fe, Co, Cu) 不存在马氏体 相变. 而在四方畸变过程中 Ga₂MnCr 和 Ga₂NiCr 分别在 c/a = 1.28, c/a = 1.1处存在一个稳定的四 方相; 其能量差 ΔE (四方相与立方相之间的能量 差) 分别为 -8.26 meV 和 -6.14 meV. 此外, 声子谱 计算结果进一步表明, Ga₂MnCr 的声子谱存在虚 频, 有声子模软化的行为.

2 计算方法和模型

本文中的 Ga₂*X*Cr (*X* = Mn, Fe, Co, Ni, Cu) 的所有计算都是采用 DFT 理论的平面波基组的 总能软赝势方法 CASTEP^[23](cambridge sequential total energy package) 模块计算. 交换关联能 采用 Ceperlev 和 Alder 所提出来的局域密度近似 (LDA), 它是将密度相同的均匀电子气的交换泛函 看做对应的非均匀系统的近似值, 可以得到较好的 效果. 原子核和电子间的相互作用采用超软赝势来 描述, 平面波截止能量为500 eV, 总能和态密度的 布里渊区 *k* 点网格为15×15×15, 自洽迭代收敛精 度为1×10⁻⁶ eV/atom.



图 1 (a) Ga₂*X*Cr 的 *L*2₁ 结构; (b) Ga₂*X*Cr 的四方畸 变结构

对于 Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu), 根据 Heusler 合金的价电子数占位规则^[24], Ga占

A(0, 0, 0)和C(1/2, 1/2, 1/2)位, Cr 占B(1/4, 1/4, 1/4)位, X 占D(3/4, 3/4, 3/4)位, 形成高有序的 $L2_1$ 面心点阵结构Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu), 它的计算结构模型如图1(a)所示, 其化 学式为 Z_2 XY此外在晶格常数优化中还考虑了反 Heusler 合金的Hg₂CuTi型结构, 其中Ga 占A(0, 0, 0)和B(1/4, 1/4, 1/4)位, 价电子数多的X原子占 C(1/2, 1/2, 1/2)位, 价电子数较少的Cr原子倾向 于占D(3/4, 3/4, 3/4)位. 计算Ga₂XCr四方畸变 的过程如图1(b)所示. 根据Heusler 合金马氏体相 变前后体积变化不大的特点^[25-31], 计算中保持晶 格的体积不变沿c轴方向拉伸或压缩.

3 结果及讨论

3.1 晶格常数和磁矩

为了获得 Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu) 基态(0 K)的平衡晶格常数,分别对Ga₂XCr的 L21 和Hg2CuTi结构的铁磁态(FM)、顺磁态(PM) 和反铁磁态(AFM)进行了晶格优化,优化结果如 图 2 所示. 从图 2 的曲线可知, $Ga_2 XCr$ (X = Mn, Fe, Co, Cu) L21 结构的铁磁态的能量最低, 说明 Ga₂XCr的稳定态结构均为铁磁态的L2₁结构;而 Ga₂NiCr L2₁ 结构的亚铁磁态的能量最低, 表明 Ga₂XCr的稳定态结构均为亚铁磁态的L2₁结构. 在基于 CASTEP 模块的计算中,除了 Ga₂MnCr之 外,在 Ga_2XCr (X = Fe, Co, Cu)体系中即使我们 在计算初始设置中把原子之间的磁结构设置为反 平行(AFM)态,但最终也得到了FM的计算结果, 即程序自动寻找到了能量最低的FM态,这间接 说明了Ga₂XCr体系中铁磁态比反铁磁态的能量 更低;而在Ga2NiCr中AFM态和FM态的计算得 出的磁结构则均为反平行(亚铁磁, FIM)态,说明 Ga₂NiCr L2₁结构的亚铁磁态的能量最低. 计算结 果和前人报道的Ga2MnCo^[20,32], Al2MnCo^[21]和 Ga₂MnNi^[22]的结构一致,都是高有序的L2₁结构, 表明我们的计算是合理的.

表1 L21型 Ga2XCr 立方相的晶格常数、总磁矩及原子的磁矩

$Ga_2 X Cr$	晶格常数	$M_{\not \otimes}$	M_X	$M_{\rm Cr}$	$M_{\rm Ga}$
	$a/{ m \AA}$	$/\mu_{ m B}$	$/\mu_{ m B}$	$/\mu_{ m B}$	$/\mu_{ m B}$
${\rm Ga_2MnCr}$	5.8179	4.12	1.56	2.34	0.08
$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{FeCr}$	5.7581	3.09	0.48	2.44	0.08
Ga_2CoCr	5.8158	2.94	0.20	2.58	0.08
$\mathrm{Ga}_2\mathrm{NiCr}$	5.8225	2.42	-0.04	2.36	0.06
Ga_2CuCr	5.9444	3.11	0.06	2.86	0.10

表1为计算得出来的Ga₂XCr的平衡晶格常数、总磁矩和各个原子的自旋磁矩. 从表1中可看出,在Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu)的总磁矩中, Cr原子对总磁矩的贡献最大, Mn原子对总磁矩也有较大贡献, Co和Fe原子只提供很小的磁矩,而Ga和X原子(Ni, Cu)的磁矩几乎为零. Heusler 合金的磁性质是由它的晶体结构所决定. 如图1(a)所示,在Ga₂XCr晶体中,与Cr原子

最近邻的是8个Ga原子,次近邻的是6个Mn原子, 而Cr原子之间的间隔为第三近邻. Cr原子之间 的磁耦合作用是通过Mn和Ga提供的巡游电子来 实现的^[27],这与Ni₂MnGa中的情形是相似的. 从 表1还可知,Ga₂CrCu的晶格常数最大而Ga₂CrFe 的晶格常数最小,Ga₂CrCo的晶格常数为5.8158 Å 和Ga₂MnCo^[32]的实验晶格常数5.84 Å很接近,这 进一步说明本研究中计算的合理性.



图 2 Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu)的 L_{21} 和 Hg₂CuTi两种结构分别在铁磁态 FM、无磁态 PM 和反铁磁 态 AFM 条件下晶格常数的优化 (a) Ga₂MnCr 的晶格常数优化; (b) Ga₂FeCr 的晶格常数优化; (c) Ga₂CoCr 的晶格常数优化; (d) Ga₂NiCr 的晶格常数优化; (e) Ga₂CuCr 的晶格常数优化

3.2 四方畸变

图 **3**为Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu)在 恒体积畸变情况下计算的总能差 ΔE 随c/a(畸变 度)的变化曲线. 从图 **3** (a)中可看出, Ga₂XCr (X = Fe, Co, Cu)随着c/a的变化,总能差 ΔE 最小 值始终保持在c/a = 1处,说明立方相是稳定态. 图 3 (a) 也清晰显示 Ga₂CuCr 在 1.20 < c/a < 1.50 范围中出现能量最小值,但仍比立方相 (c/a = 1) 能量高,这只是在畸变过程中出现的局部亚稳态. 由此可知, Ga₂XCr (X = Fe, Co, Cu)的立方相 (c/a = 1)是稳定态,所以在 Ga₂XCr (X = Fe, Co, Cu)体系中不能发生马氏体相变.

综合前人的实验结果分析可知, Heusler 合金

体系要发生马氏体相变需满足两个条件: i) 具备 充足的驱动力ΔE(四方马氏体相与立方母相之 间的能量差)可以克服相变过程中产生的阻力; ii)适当的畸变度,c/a的大小通常为1.2—1.3^[33]. 图 3 (b) 为 Ga₂MnCr, Ga₂NiCr 和 Ni₂MnGa 的驱动 力随畸变度变化的曲线,其中Ni₂MnGa的数据 来自于Sahariah的计算结果^[34]. 图3(b)可知, Ga_2NiCr 的能量差 ΔE 随着c/a的变化在1.11处 出现一个能量最小值. Ga₂NiCr的驱动力为 $\Delta E = -6.14 \text{ meV} \Rightarrow \text{Ni}_2 \text{MnGa} \text{ in } \Delta E(-7.26 \text{ meV})$ 相当, 但相比Ni₂MnGa (c/a = 1.22), 其畸变度 c/a = 1.11 偏小. 而前人基于第一性原理计算 Ni₂MnGa^[34], Mn₂NiGa^[35]和Ni₂FeGa^[34]的能量 最小值对应的c/a值分别为1.22, 1.23和1.33. 其 中,对于Ni₂MnGa^[36],随着温度的降低,该体系 发生马氏体相变,由立方L21相转变为L10四方相, 其四方相的晶格常数为a = b = 5.47Å, c = 6.60Å, c/a = 1.207. 计算结果都与实验测量结果相符合, 且c/a均落入1.2—1.3的相变范围内.由此,可以推 断Ga₂NiCr体系c/a = 1.11的畸变度难以发生马 氏体相变,虽然在该体系中存在结构失稳的倾向.

相 比 Ga₂NiCr 只 有 一 个 能 量 最 小 值, Ga₂MnCr 的 能 量 差 ΔE 随 着 c/a 的 变 化 分 别 在 c/a = 1.11, 1.28 处 出 现 两 个 能 量 最 小 值. 其中 在 c/a = 1.11 处 是 Ga₂MnCr 在 畸 变 过 程 中 的 一 个 亚 稳态;而 在 c/a = 1.28 处 的 能 量 更 低,所 以 Ga₂MnCr 倾 向 于 在 c/a = 1.28 处 达 到 稳 定 态,对 应 的 驱 动 力 为 $\Delta E = -8.26$ meV 比 Ni₂MnGa 的 $\Delta E(-7.26$ meV) 还 大. 综 上 分 析 可 知,Ga₂MnCr 拥 有 足 够 大 的 驱 动 力 和 适 当 的 畸 变 度,满 足 发 生 马 氏 体 相 变 的 两 个 条 件,因此 可 推断 Ga₂MnCr 体 系 中 有 可 能 存 在 马氏体 相 变.



图 3 (网刊彩色) (a) Ga₂*X*Cr (*X* = Fe, Co, Cu) 的总能差 $\Delta E = c/a$ 的关系; (b) Ga₂*X*Cr (*X* = Mn, Ni) 和 Ni₂MnGa 的总能差 $\Delta E = c/a$ 的关系

3.3 Ga₂NiCr和Ga₂MnCr态密度对四方 畸变的响应

我们知道,费米能级附近的电子结构也会敏感 地影响相稳定性^[37].如果体系的费米能级附近存 在尖锐的电子态密度峰,体系将处于高能量的状态 而不稳定.Ni₂MnGa已有的第一性原理计算表明, 其相变的驱动力主要来自于Jahn-Teller 畸变^[38]和 费米面颈缩^[39,40].因此,深入地理解相变过程中电 子结构的变化行为对于材料的设计和提高材料的 功能特性有很大的帮助.在本研究四方畸变的过程 中,伴随着*c*轴的拉伸或压缩,晶格内的原子间距 会发生改变,原子之间的杂化也会发生改变,从而 导致电子的态密度分布也发生变化.图4(a)和(b) 所示分别是Ga₂MnCr和Ga₂NiCr在四方畸变的过 程中立方相和四方相的总态密度及各个原子的分态密度.由图4(a)可看出,立方相Ga₂MnCr的总态密度在自旋向下方向的费米能级附近有两个峰,其中一个位于费米能级下方 –0.29 eV处,另一个位于费米能级上方 0.16 eV处.由图4(a)立方相中的分态密度分布可知,这两个峰主要来源于 Mn 原子和 Cr 原子的 3d 电子之间强烈的 d-d 杂化.随着 c/a的变化,这两个峰发生变化,最终在 c/a = 1.28的四方相趋于平坦.我们知道,奥氏体相和马氏体相之间的能量差 ΔE 与它们之间的态密度分布的演变之间存在对应关系,这点在 Ni₂Mn_{1+x}Sn_{1-x}^[40]体系的理论和实验研究中都得到了验证.相应地,Ga₂MnCr 体系的总能也随之降低.另外,立方相Ga₂MnCr 自旋向上的总态密度在位于费米能级上方 1.01 eV 处有一个主峰,畸变后往高能区域移动



图 4 (网刊彩色) (a), (b) Ga₂MnCr 在立方相 c/a = 1和四方相 c/a = 1.28时的总态密度和分态密度; (c), (d) Ga₂NiCr 在立方相 c/a = 1和四方相 c/a = 1.11时的总态密度和分态密度

至 1.70 eV (四方相 c/a = 1.28) 处,同时峰的强度减弱. 峰强度减弱主要是 Mn 原子和 Cr 原子之间的 d 带在更宽能量范围内杂化所致. 由图 4 (a) 可知, 畸变过程中 Ga₂MnCr 态密度的重新分布主要来源于在四方畸变过程中 Mn-Cr 原子的间距减小从而使它们之间的 d-d 杂化强度增强.

由图4(c)可知, 立方相Ga₂NiCr自旋向上的 总态密度在位于费米能级上方0.11 eV 处有个尖峰. 由图4(c)立方相中的分态密度分布可知,该峰主要 来源于Ni原子和Cr原子的3d电子之间强烈的d-d 杂化. 随着 c/a 的变化, 这个峰倾向于发生劈裂, 最 终在c/a = 1.1的四方相劈裂为两个峰如图4(d)所 示,其中一个位于费米能级上方0.27 eV处,另一 个位于费米能级下方-0.58 eV处. 这说明在更宽 的能量范围内, Ga₂NiCr 的Ni 原子和Cr 原子的3d 电子之间的d-d杂化可增强立方相的稳定性.相 应地, Ga₂NiCr体系的总能也随之降低.此外, 立 方相Ga2NiCr自旋向下的总态密度在费米能级下 方-0.17 eV处也存在一个主峰,这峰主要也是来 源于Ni-Cr的3d电子之间强烈的d-d杂化,畸变后 往高能区域移动至 -0.05 eV (四方相 c/a = 1.11) 处,同时峰的强度也有微小的减弱.综上分析可知, Ga₂NiCr的立方结构为亚稳相,然而其畸变度仅为

c/a = 1.11没有满足相变所需的畸变度 (1.2—1.3). 因此, Ga₂NiCr 体系中不存在马氏体相变.

3.4 Ga₂NiCr和Ga₂MnCr磁性对四方畸 变的响应

由Ga₂NiCr和Ga₂MnCr态密度的分析可知, 在四方畸变的过程中由于晶格内的原子间距发生 改变,原子之间的杂化强度会发生变化从而改变它 们的态密度, 而态密度的改变将导致体系磁矩的 变化. 图 5 (a), (b) 所示分别是 Ga₂MnCr 的总磁矩 及原子磁矩与c/a的关系, Ga₂NiCr的总磁矩及原 子磁矩与c/a的关系. 从图5(a1)可知, Ga₂MnCr 在马氏体附近c/a = 1.25处总磁矩最大, 磁矩的 增大与Mn和Cr原子的磁矩有关. Ga2MnCr的 总磁矩在0.95 < c/a < 1.13范围内曲线的变化 趋势是先保持不变然后逐渐降低, 在c/a = 1.2处有最小值4.09 μ_B,表明微小的畸变不会显著 改变体系中原子的自旋极化分布. 由图5(a2) 可知, 0.95 < c/a < 1.13 磁矩的变化主要由Cr 原子的磁矩主导. 在1.13 < c/a < 1.35 范围内 Ga_2MnCr 的总磁矩先增加在c/a = 1.25处总磁矩 有最大值4.22 μ_B然后逐渐降低, 而四方相能量最 低 (c/a = 1.28) 时, 磁矩为 4.21 $\mu_{\rm B}$. 由图 5 (a3) 可

知1.13 < c/a < 1.25 磁矩的增加主要是由 Mn 原子的磁矩变化主导的,而1.25 < c/a < 1.35 总磁矩的下降是由 Cr 原子的磁矩变化趋势而决定的.在四方畸变的过程中原子的磁矩变化与其态密度的变化是一致的.由图4(a)可知立方相 Cr 原子的分态密度在自旋向上方向能量为 –0.74 eV 和1.01 eV 处有两个峰,畸变之后在四方相中它们分别位于0.38 eV 和1.7 eV 处,如图4(b)所示;类似地,Cr 原子的分态密度在自旋向下方向1.15 eV 和2.78 eV 处有两个峰,畸变之后它们也往高能级移动.这表明在畸变过程中 Cr 原子的3d 电子往高能级移动从而使自旋向上和向下之间的电子分布差减小,因此Cr 原子的磁矩随着畸变呈基本不变(略有减小)的趋势.从图4(a)中我们可知立方相 Mn 的态密度在

自旋向下方向能量为-0.29 eV 和0.16 eV处的峰 畸变时会发生劈裂最终趋于平坦,从而使电子在 自旋向下方向的分布发生改变;而立方相 Mn 的态 密度在自旋向上方向的峰在畸变中都往高能级区 域移动. Mn 的态密度的变化趋势表明 Mn 原子自 旋向上和向下之间的 3d 电子分布差增大,所以在 畸变中 Mn 磁矩程逐渐上升的趋势.在畸变的过程 中,Ga₂MnCr中Cr和 Mn 原子的磁矩分别呈一减 一增的变化趋势,最终导致 Ga₂MnCr 的总磁矩在 c/a = 1.15 处有最小值(4.09 μ_B).此外,Ga₂MnCr 中 Cr 和 Mn 原子的磁矩分别呈一减一增的变化趋 势也表明电子由 Mn 原子向 Cr 原子转移.综上分 析可知,在畸变过程中Ga₂MnCr 的总磁矩变化不 明显,四方相的磁矩比立方相的磁矩大2.18%.



图 5 (a) Ga₂MnCr 的总磁矩及原子磁矩与 *c/a* 的关系, (a1) 总磁矩与 *c/a* 的关系, (a2) Cr 磁矩与 *c/a* 的关系, (a3) Mn 磁矩与 *c/a* 的关系; (b) Ga₂NiCr 的总磁矩及原子磁矩与 *c/a* 的关系, (b1) 总磁矩与 *c/a* 的关系, (b2) Cr 磁矩与 *c/a* 的关系, (b3) Ni 磁矩与 *c/a* 的关系

Ga₂NiCr的磁矩变化与Ga₂MnCr相比,其变 化趋势较简单.由图5(b1)可知,在c/a < 1范围内 (压缩c轴),Ga₂NiCr的总磁矩随着c/a值的增大是 单调递减的,在c/a = 1立方相Ga₂NiCr的磁矩最 小2.41 μ_B ;当c/a > 1(拉伸c轴)时,Ga₂NiCr的磁 矩随着c/a的增大单调递增,在四方相能量最低点 c/a = 1.11处磁矩为2.62 μ_B .由图5(b2)可知,Cr 原子磁矩随c/a的变化趋势与总磁矩的变化趋势 相似,这说明在四方畸变过程中,Cr原子的磁矩变 化决定了Ga₂NiCr总磁矩的变化.此外,Ni原子磁 矩随c/a的变化与总磁矩和Cr原子磁矩的趋势是 一致的.由图5(b2)可知Ga₂NiCr体系中的Cr原 子磁矩(c/a > 1)的变化趋势是单调递增的,而在 Ga₂MnCr体系中Cr原子磁矩(c/a > 1)却呈逐渐 递减的趋势. 从图 4 (c) 可知立方相 Cr 的分态密度 在自旋向上方向能量为-1.40 eV 处的峰在畸变中 其强度会减低, 同时费米能级处的峰往高能级移 动; Cr 的分态密度在自旋向下方向费米能级附近 的峰也往高能区域移动. 在畸变的过程中, Cr 原子 分态密度的变化使得其自旋向上和自旋向下之间 的 3d 电子分布差增大, 因此 Cr 磁矩 (c/a > 1) 的变 化趋势是单调递增的, 且在 c/a = 1 处有最小值. 由以上分析可知, Ga₂NiCr 四方相的总磁矩比立方 相的总磁矩大 8.71%.

3.5 Ga₂MnCr和Ga₂FeCr的声子振动谱

具有马氏体相变的Heusler 合金的立方母相结构是非稳态,四方畸变会降低体系的能量,这

表明四方相是体系的最终稳定态.可以通过计 算体系的声子谱来描述Heusler 合金的结构是否 稳定,如果声子谱出现虚频则说明体系是非稳 态^[41,42].事实上,在Heusler 合金中 $L2_1$ 相的结构 不稳定与费米面颈缩有密切的关系^[25],而费米面 颈缩也可导致体系的声学谱发生软化.为了作比 较,我们分别计算了具有潜在相变的Ga₂MnCr和 无相变的Ga₂FeCr两个代表体系的声子振动谱,如 图6(a)和(b)所示.由图6(a)可知,横波振动沿 着 $L \rightarrow W, X \rightarrow W$ 和 $X \rightarrow G$ 方向出现虚频,这 表明Ga₂MnCr的 $L2_1$ 结构是非稳态,会发生晶格 的软化,这与计算所得四方畸变使 Ga₂MnCr 的能 量降低相一致. 声子软化的情形在 Heusler 合金 Ni₂MnX (X = Al, Ga, In, Ge)^[43] 中也观察到 $L2_1$ 结构的 Ni₂MnX 声子谱的声学支横波在 [110] 方向 上都出现虚频,即声子模发生软化.综上分析可知, $L2_1$ 结构的 Ga₂MnCr 是非稳态,其声子振动谱存 在虚频,因此 Ga₂MnCr 有可能存在四方畸变的马 氏体相变. 而在图 6 (b)中 Ga₂FeCr 的声子谱不存 在虚频,说明 Ga₂FeCr 在 $L2_1$ 结构的状态下是稳定 的,不存在马氏体相变.



图 6 $L2_1$ 结构的 Ga₂MnCr(a) 和 Ga₂FeCr (b) 的声子振动谱.

4 结 论

2 1 0

- 1

 $-2 \\ -3$

-4

频率/THz

运用基于密度泛函理论的第一性原理方法, 采用 CASTEP 模块对 $L2_1$ 型 Heusler 合金 Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu)的晶体结构、四方畸 变、磁性、电子结构、声子谱等进行了计算.通过 计算结果分析可得出以下结论:在四方畸变中,1) Ga₂XCr (X = Fe, Co, Cu)的立方相(c/a = 1)是 稳定态,不存在马氏体相变;2)对于 Ga₂MnCr和 Ga₂NiCr,二者分别在c/a = 1.28和1.11处存在一 个稳定的四方相,其能量差 ΔE 分别为 -8.26 meV 和 -6.14 meV;3) Ga₂MnCr 总磁矩由 Cr 原子和 Mn 原子共同提供,而 Ga₂NiCr 总磁矩的主要贡献 者为 Cr 原子,在四方畸变过程中,二者的磁矩分别 增加了 2.18% 和8.71%;4) Ga₂MnCr 的声子谱存在 虚频,表明 Ga₂MnCr 是非稳态,存在马氏体相变的 可能.

参考文献

- Wu G H, Yu C H, Meng L Q, Chen J L, Yang F M, Qi S R, Zhan W S, Wang Z, Zheng Y F, Zhao L C 1999 *Appl. Phys. Lett.* **75** 2990
- [2] Kainuma R, Imano Y, Ito W, Sutou Y, Morito H, Okamoto S, Kitakami O, Oikawa K, Fujita A, Kanomata T, Ishida K 2006 *Nature* **439** 957
- [3] Hu F X, Shen B G, Sun J R, Wu G H 2001 *Phys. Rev.* B 64 132412
- [4] Yu S Y, Liu Z H, Liu G D, Chen J L, Cao Z X, Wu G H, Zhang B, Zhang X X 2006 Appl. Phys. Lett. 89 162503
- [5] Dubenko I, Pathak A K, Stadler S, Ali N, Kovarskii Y, Prudnikov V N, Perov N S, Granovsky A B 2009 *Phys. Rev. B* 80 092408
- [6] Ma L, Wang W H, Lu J B, Li J Q, Zhen C M, Hou D
 L, Wu G H 2011 Appl. Phys. Lett. 99 182507
- [7] Karaca H E, Karaman I, Basaran B, Ren Y, Chumlyakov Y I, Maier H J 2009 Adv. Funct. Mater. 19 983
- [8] Chmielus M, Zhang X X, Witherspoon C, Dunand D C, Mullner P 2009 Nat. Mater. 8 863
- [9] Sarawate N, Dapino M 2006 Appl. Phys. Lett. 88 121923
- [10] Manosa L, Gonzalez-Alonso D, Planes A, Bonnot E, Barrio M, Tamarit J L, Aksoy S, Acet M 2010 Nat. Mater. 9 478
- [11] Webster P J, Ziebeck K R A, Town S L, Peak M S 1984 *Philos. Mag. B* 49 295
- [12] Sutou Y, Imano Y, Koeda N, Omori T, Kainuma R, Ishida K, Oikawa K 2004 Appl. Phys. Lett. 85 4358

- [13] Liu Z H, Zhang M, Cui Y T, Zhou Y Q, Wang W H, Wu G H, Zhang X X, Xiao G 2003 Appl. Phys. Lett. 82 424
- [14] Liu G, Chen J, Liu Z, Dai X, Wu G, Zhang B, Zhang X 2005 Appl. Phys. Lett. 87 262504
- [15] Oikawa K, Ota T, Gejima F, Ohmori T, Kainuma R, Ishida K 2001 Mater. Trans. 42 2472
- [16] Wuttig M, Li J, Craciunescu C 2001 Scr. Mater. 44 2393
- [17] Xu X, Omori T, Nagasako M, Okubo A, Umetsu R Y, Kanomata T, Ishida K, Kainuma R 2013 Appl. Phys. Lett. 103 164104
- [18] Jenkins C, Scholl A, Kainuma R, Elmers H J, Omori T 2012 Appl. Phys. Lett. 100 032401
- [19] Zhu W, Liu E K, Feng L, Tang X D, Chen J L, Wu G
 H, Liu Z H, Meng F B, Luo H Z 2009 *Appl. Phys. Lett.* 95 222512
- [20] Shiraishi H, Sugamura M, Hori T 1987 J. Magn. Magn. Mater. 70 230
- [21] Shiraishi H, Hori T, Yamaguchi Y 1992 J. Magn. Magn. Mater. 104–107, Part 3 2040
- [22] Barman S R, Chakrabarti A, Singh S, Banik S, Bhardwaj S, Paulose P L, Chalke B A, Panda A K, Mitra A, Awasthi A M 2008 Phys. Rev. B 78 134406
- [23] Clark S J, Segall M D, Pickard C J, Hasnip P J, Probert M I J, Refson K, Payne M C 2009 Z. Kristallogr. 220 567
- [24] Niculescu V, Burch T, Raj K, Budnick J 1977 J. Magn. Magn. Mater. 5 60
- [25] Zayak A, Entel P, Rabe K, Adeagbo W, Acet M 2005 *Phys. Rev. B* 72 054113
- [26] Luo L J, Zhong C G, Dong Z C, Fang J H, Zhou P X, Jiang X F 2010 Acta Phys. Sin. 59 8037 (in Chinese)
 [罗礼进, 仲崇贵, 董正超, 方靖淮, 周朋霞, 江学范 2010 物 理学报 59 8037]
- [27] Luo L J, Zhong C G, Jiang X F, Fang J H, Jiang Q 2010
 Acta Phys. Sin. 59 521 (in Chinese) [罗礼进, 仲崇贵, 江 学范, 方靖淮, 蒋青 2010 物理学报 59 521]
- [28] Luo L J, Zhong C G, Fang J H, Zhao Y L, Zhou P X, Jiang X F 2011 Acta Phys. Sin. 60 127502 (in Chinese)
 [罗礼进, 仲崇贵, 赵永林, 方靖淮, 周朋霞, 江学范 2011 物 理学报 60 127502]

- [29] Luo L J, Zhong C G, Dong Z C, Fang J H, Zhou P X, Jiang X F 2012 Acta Phys. Sin. 61 207503 (in Chinese) [罗礼进, 仲崇贵, 董正超, 方靖淮, 周朋霞, 江学范 2012 物 理学报 61 207503]
- [30] Luo H Z, Jia P Z, Liu G D, Meng F B, Liu H Y, Liu E K, Wang W H, Wu G H 2013 Solid State Commun. 170 44
- [31] Luo H Z, Meng F B, Liu G D, Liu H Y, Jia P Z, Liu E K, Wang W H, Wu G H 2013 Intermetallics 38 139
- [32] Li G J, Liu E K, Zhang Y J, Du Y, Zhang H W, Wang W H, Wu G H 2013 J. Appl. Phys. 113 103903
- [33] Winterlik J, Chadov S, Gupta A, Alijani V, Gasi T, Filsinger K, Balke B, Fecher G H, Jenkins C A, Casper F, Kubler J, Liu G D, Gao L, Parkin S S, Felser C 2012 Adv. Mater. 24 6283
- [34] Sahariah M B, Ghosh S, Singh C S, Gowtham S, Pandey R 2013 J. Phys.: Condes. Matter 25 025502
- [35] Felser C, Alijani V, Winterlik J, Chadov S, Nayak A K 2013 IEEE Trans. Magn. 49 682
- [36] Sozinov A, Likhachev A A, Lanska N, Ullakko K 2002 Appl. Phys. Lett. 80 1746
- [37] Lin W, Xu J H, Freeman A J 1992 Phys. Rev. B 45 10863
- [38] S. I. Shinpei Fujii, Setsuro Asano 1989 J. Phys. Soc. Jpn. 58 3657
- [39] Opeil C P, Mihaila B, Schulze R K, Mañosa L, Planes A, Hults W L, Fisher R A, Riseborough P S, Littlewood P B, Smith J L, Lashley J C 2008 *Phys. Rev. Lett.* 100 165703
- [40] Ye M, Kimura A, Miura Y, Shirai M, Cui Y T, Shimada K, Namatame H, Taniguchi M, Ueda S, Kobayashi K, Kainuma R, Shishido T, Fukushima K, Kanomata T 2010 Phys. Rev. Lett. 104 176401
- [41] Stuhr U, Vorderwisch P, Kokorin V V 2000 J. Phys.: Condes. Matter 12 7541
- [42] Zayak A T, Adeagbo W A, Entel P, Rabe K M 2006 Appl. Phys. Lett. 88 111903
- [43] Zayak A T, Entel P, Rabe K M, Adeagbo W A, Acet M 2005 Phys. Rev. B 72 054113

First-principles investigations on tetragonal distortion, electronic structure, magnetism, and phonon dispersion of Ga_2XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu) Heusler alloys^{*}

Chen Jia-Hua¹⁾²⁾ Liu En-Ke^{2)†} Li Yong²⁾³⁾ Qi Xin^{1)‡} Liu Guo-Dong³⁾ Luo Hong-Zhi³⁾ Wang Wen-Hong²⁾ Wu Guang-Heng²⁾

1) (College of Science, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China)

2) (State Key laboratory of Magnetism, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

3) (School of Materials Science and Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China)

(Received 3 May 2014; revised manuscript received 3 November 2014)

Abstract

In Ga₂-based Heusler alloys Ga₂XCr (X = Mn, Fe, Co, Ni, Cu) the tetragonal distortion, electronic structure, magnetism and phonon dispersion have been studied by first-principles calculations based on the density functional theory. The volume-conserving tetragonal distortions of the cubic Ga₂XCr show that Cr atom makes the greatest contribution to the total magnetic moment. No martensitic transformation has been found in Ga₂FeCr, Ga₂CoCr and Ga₂CuCr. For both Ga₂MnCr and Ga₂NiCr, the tetragonal phase is lower in energy as compared with the cubic phase. Ga₂MnCr and Ga₂NiCr have the lowest total energy at c/a = 1.28 and 1.11, respectively. Correspondingly, the energy difference ΔE between the cubic and the tetragonal phase is -8.26 meV in Ga₂MnCr and -6.14 meV in Ga₂NiCr. For Ga₂MnCr and Ga₂NiCr, calculations of electronic structure and phonon dispersion reveal that a sharp peak near the Fermi level will lead to a structural instability by increasing the energy of the system, which can result in a broadening in the energy range due to hybridizations between 3d electrons as well as the potential structural transformation. With proper c/a and ΔE a potential tetragonal martensitic transformation can be expected in Ga₂MnCr, the phonon dispersion of which further shows that the acoustic modes tend to be softened.

Keywords: Heusler alloys, ferromagnetic martensitic transformation, first-principles calculationsPACS: 71.20.-b, 81.30.Kf, 75.50.CcDOI: 10.7498/aps.64.077104

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 51301195, 51275029).

[†] Corresponding author. E-mail: ekliu@iphy.ac.cn

[‡] Corresponding author. E-mail: qixin@mail.buct.edu.cn